

**КТ3157А**

**PNP КРЕМНИЕВЫЙ ЭПИТАКСИАЛЬНО – ПЛАНАРНЫЙ ТРАНЗИСТОР**

аАО.336.727 ТУ/02

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ В МОДУЛЕ ВИДЕОУСИЛИТЕЛЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ И ДРУГИХ КАСКАДАХ АППАРАТУРЫ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

- \* Зарубежный аналог - ВФ423
- \* Изготавливается в корпусе **КТ-26 (ТО-92)**.



1 – Коллектор 2 – Эмиттер 3 – База

**ПРЕДЕЛЬНО- ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Параметры	Обозначение	Ед. измер.	Значение
Напряжение коллектор-база	Укб max	В	-250
Напряжение коллектор-эмиттер	Укэ max	В	-250
Напряжение эмиттер-база	Уэб max	В	-5
Постоянный ток коллектора	Ik max	мА	-30
Импульсный ток коллектора	Iки max	мА	-100
Постоянный ток базы	Iб max	мА	-20
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора	Pк max	мВт	200
Температура перехода	Tj	°С	150

**ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ( Токp.ср.=25°С )**

Параметры	Обозначение	Ед. измер	Режимы измерения	Min	Max
Граничное напряжение коллектор - эмиттер	Укэо гр.	В	Ik= -10мА, Iб=0	-250	
Обратный ток коллектора	Iкбо	мкА	Укб=-250В, Iэ=0		-0,1
Обратный ток эмиттера	Iэбо	мкА	Уэб=-5В		-10
Обратный ток коллектор-эмиттер	Iкэг	мкА	Укэ=-250В, Rбэ=10кОм		-10
Статический коэффициент передачи тока	h21E		Укб=-19В, Iэ=-25мА	50	
Напряжение насыщения коллектор- эмиттер	Укэ(нас)	В	Ik=-15мА, Iб=-3мА		-1,0
Напряжение насыщения база - эмиттер	Убэ(нас)	В	Ik=-15мА, Iб=-3мА		-1,2
Емкость коллекторного перехода	Ск *	пФ	Укб=-30В, f=10МГц		5,5
Емкость эмиттерного перехода	Сэ *	пФ	Уэб=-0,5В, f=10МГц		50
Граничная частота коэффициента передачи тока	fгр *	МГц	Укб=-10В, Iэ=-10мА	60	

\* Справочные параметры

**220108, г. Минск, ул. Корженевского, 16, УП "Завод ТРАНЗИСТОР"**

**Отдел маркетинга: тел./факс (10-37517) 212-59-32**

**E-mail: [market@transistor.com.by](mailto:market@transistor.com.by) <http://www.transistor.by>**